



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский
университет «Московский институт
электронной техники»

Шокина пл., д.1, г. Зеленоград, Москва, 124498

Тел.: +7(499) 731 44 41 Факс: +7(499) 710 22 33

E-mail: netadm@miet.ru <http://www.miet.ru>

ОГРН 1027739615584

13.04.2023 № 94 - 1389/4-8
на № _____

Председателю совета по защите диссертаций на
соискание учёной степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук,
24.2.435.01, созданного на базе ФГБОУ ВО
«Юго-Западный государственный университет»,
д. ф.-м. н., профессору
Кузьменко Александру Павловичу

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» сообщает о своем согласии выступить в качестве ведущей организации по диссертации соискателя *Лузянина Сергея Евгеньевича на тему «Электрические свойства ограниченных полупроводников с естественными и искусственными неоднородностями»*, представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.11. Физика полупроводников.

Сведения о ведущей организации

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
Сокращенное наименование организации	МИЭТ
Ведомственная принадлежность	Министерство науки и высшего образования РФ
Почтовый индекс, адрес организации	124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1
Телефон	(499) 731-44-41
Адрес электронной почты	netadm@miee.ru
Сайт (при наличии)	www.miet.ru

Публикации работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние пять лет (не более пятнадцати):

1	Электронно-микроскопические исследования влияния отжига на тонкие пленки Ge-Sb-Te, полученные методом вакуумно-термического испарения / Ю. С. Зыбина, Н. И. Боргардт, П. И. Лазаренко [и др.] // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2019. – № 10. – С. 82-87.
2	Лавров И. В. Метод прогнозирования эффективной проводимости текстурированных поликристаллов с учетом межкристаллитных промежутков / И. В. Лавров // Известия высших учебных заведений. Электроника. – 2020. – Т. 25, № 4. – С. 299-309.
3	Разворот слоёв GaAs в гетероструктурах GaAs/Ge/GaAs / И.П. Казаков, С. А. Зиновьев, А. В. Клековкин, В.А. Сазонов, В.Н. Кукин, Н.И. Боргардт // Краткие сообщения по физике ФИАН. – 2020. – Т. 47, № 12. – С. 3-10.

4	Structure of Ge ₂ Sb ₂ Te ₅ thin films near the inflection point of the resistivity temperature dependence / Y. Zaytseva, P. Lazarenko, A. Yakubov [et al.] // Chalcogenide Letters. – 2020. – Vol. 17, No 2. – P. 41-47.
5	Effective Thermal Conductivity of Composites with Contact Thermal Resistance between the Inclusions and the Matrix / I. V. Lavrov, A. A. Kochetygov, V. V. Bardushkin [et al.] // Russian Engineering Research. – 2020. – Vol. 40, No 8. – P. 622-627.
6	Особенности формирования тонких слоев AlN молекулярно-лучевой эпитаксией на темплейтах 3C-SiC/Si(111) с ON-AXIS и 4° OFF-AXIS разориентацией / А. В. Бабаев, В. К. Неволин, В. Н. Стаценко [и др.] // Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. – 2020. – № 1. – С. 102-108.
7	Электронно-микроскопические исследования структуры тонких эпитаксиальных слоев Ge ₂ Sb ₂ Te ₅ , выращенных на подложке Si(111) / Ю. С. Зайцева, Н. И. Боргардт, А. С. Приходько [и др.] // Известия высших учебных заведений. Электроника. – 2021. – Т. 26, № 3-4. – С. 214-225.
8	Моделирование эффективной диэлектрической проницаемости пенополимерных материалов / И. В. Лавров, В. В. Бардушкин, В. Б. Яковлев, А. В. Бардушкин // Известия высших учебных заведений. Электроника. – 2021. – Т. 26, № 2. – С. 115-122.
9	Обобщенное приближение Максвелла Гарнетта для текстурированных матричных композитов с включениями в оболочке / В. И. Колесников, И. В. Лавров, В. В. Бардушкин [и др.] // Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки. – 2021. – Т. 498, № 1. – С. 11-16.
10	Исследование ионной имплантации азота через слой нитрида кремния для межприборной изоляции силовых GaN/Si-транзисторов / В. И. Егоркин, С. В. Оболенский, В. Е. Земляков [и др.] // Письма в Журнал технической физики. – 2021. – Т. 47, № 18. – С. 15-17.
11	Получение и исследование омических контактов с высокой адгезией к термоэлементам / М. Ю. Штерн, А. О. Козлов, Ю. И. Штерн [и др.] // Физика и техника полупроводников. – 2021. – Т. 55, № 12. – С. 1097-1104.
12	Особенности температурной стабильности сопротивления омических контактов к наногетероструктурам на основе GaAs и GaN / В. И. Егоркин, В. Е. Земляков, А. В. Неженцев [и др.] // Физика и техника полупроводников. – 2021. – Т. 55, № 12. – С. 1260-1263.
13	Features of the Morphology and Structure of Thin Silicon Films / A. V. Novak, D. I. Smirnov, A. V. Romyantsev, V. R. Novak // Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques. – 2021. – Vol. 15, No. 1. – P. 152-157.
14	Методики исследования электрического контактного сопротивления в структуре металлическая пленка — полупроводник / М.Ю. Штерн, И.С. Караваев, М.С. Рогачев [и др.] // Физика и техника полупроводников. – 2022. – Т. 56, № 1. – С. 31-37.
15	Лавров И.В. Обобщенное приближение эффективного поля для неоднородной среды с включениями в многослойной оболочке / И.В. Лавров, В.В. Бардушкин, В.Б. Яковлев // Журнал технической физики. – 2022. – Т.92, № 11. – С. 1632-1642.

Проректор по научной работе
доктор технических наук, профессор



С.А. Гаврилов